

## ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Смирнова Андрея Николаевича «Структура, термостойкость и электрические свойства многослойныхnanoструктур  $(Mg/NbO_n)_{82}$ ,  $(Mg/ZrO_2)_{52}$ ,  $(Ni/ZrO_2)_{72}$ », представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности:

1.3.8. Физика конденсированного состояния.

Диссертационная работа Смирнова Андрея Николаевича посвящена исследованию термостойкости и изменению структуры и электрических свойств многослойных nanoструктур  $(Mg/NbO_n)_{82}$ ,  $(Mg/ZrO_2)_{52}$  и  $(Ni/ZrO_2)_{72}$  при нагреве.

Многослойные пленки с толщиной слоя порядка нескольких нанометров находят широкое применение в современных функциональных элементах многочисленных технических устройств. Однако, несмотря на плюсы многослойных nanoструктур серьёзной проблемой является их невысокая термическая устойчивость. Наноразмерность слоёв или фазовых включений приводит к повышению химической активности материалов вследствие чего даже незначительный нагрев, который необходим для процессов гидрирования, может инициировать межфазное (межслоевое) взаимодействие, что приводит к разрушению слоистости структуры. Поскольку термическая устойчивость многослойной nanoструктуры во многом зависит от химической активности фаз, образующих такую структуру, актуальной задачей является изучение влияния степени химической активности формирующих материалов на свойства и термостойкость nanoструктур.

Поэтому работа А.Н. Смирнова, посвященная исследованию термостойкости и изменению структуры и электрических свойств многослойных nanoструктур  $(Mg/NbO_n)_{82}$ ,  $(Mg/ZrO_2)_{52}$  и  $(Ni/ZrO_2)_{72}$  направлена на **решении научной проблемы и является актуальной.**

Поставленные задачи в диссертационной работе решены, а цели достигнуты.

### Научная новизна.

К наиболее значимым результатам можно отнести:

- полученные ионно-лучевым распылением двух независимых мишеней с последующим осаждением материала на врачающуюся подложку многослойные наносистемы  $(Mg/NbO_n)_{82}$ ,  $(Mg/ZrO_2)_{52}$  и  $(Ni/ZrO_2)_{72}$  с градиентом толщины металлических слоев. Значения толщины одного бислоя в образцах (металл + оксид) варьируются от 0,95 до 8,5 нм;
- выявленные температурные зависимости электрического сопротивления синтезированных многослойных nanoструктур  $(Mg/ZrO_2)_{52}$  и  $(Ni/ZrO_2)_{72}$  в интервале температур 77 – 300 К. Установлено, что в дискретных многослойных nanoструктурах  $(Mg/ZrO_2)_{52}$  и  $(Ni/ZrO_2)_{72}$  в области низких температур реализуется прыжковая проводимость с переменной длиной прыжка по локализованным состояниям вблизи уровня Ферми. Показано, что в дискретных nanoструктурах  $(Mg/ZrO_2)_{52}$  и  $(Ni/ZrO_2)_{72}$  плотность электронных состояний на уровне Ферми линейно увеличивается при увеличении толщины металлического слоя ( $4 \cdot 10^{16}$  -  $5 \cdot 10^{18}$  эВ·см<sup>-3</sup> и  $10^{21}$ - $2 \cdot 10^{22}$  эВ·см<sup>-3</sup>, соответственно).
- установленные закономерности, указывающие на то, что увеличение плотности электронных состояний на уровне Ферми в многослойных nanoструктурах  $(Mg/ZrO_2)_{52}$  с толщинами бислоев более 4,6 нм после отжига при температуре 873 К, которое ранее не наблюдалось ни в композитных, ни в многослойных nanoструктурах, обуславливается окислением магниевой фазы кислородом из диоксида циркония, что приводит к увеличению концентрации дефектов (кислородных вакансий) в диокside.

## **Практическая и научная значимость**

Полученные результаты в диссертационном исследовании имеют важное, как **практическое, так и теоретическое** значение и могут быть использованы при создании термостойких многослойных наноструктур  $(\text{Mg}/\text{NbO}_n)_{82}$ ,  $(\text{Mg}/\text{ZrO}_2)_{52}$  и  $(\text{Ni}/\text{ZrO}_2)_{72}$ .

Диссидентом отработаны режимы напыления многослойных наноструктур  $(\text{Mg}/\text{NbO}_n)_{82}$ ,  $(\text{Mg}/\text{ZrO}_2)_{52}$  и  $(\text{Ni}/\text{ZrO}_2)_{72}$  с толщинами металлического и оксидного слоев порядка нескольких нанометров; показана практическая возможность получения многослойных наноструктур  $\text{Mg}/\text{ZrO}_2$  с дискретными металлическими слоями, сформированными из неокисленных наноразмерных частиц Mg; установлены толщины металлических слоёв в многослойных наноструктурах  $(\text{Mg}/\text{ZrO}_2)_{52}$  и  $(\text{Ni}/\text{ZrO}_2)_{72}$  при которых слои являются дискретными и сформированы из наноразмерных металлических частиц.

**В теоретическом плане** соискателем получены новые знания об изменении плотности электронных состояний на уровне Ферми исследуемых материалов после отжига. В работе установлено, что увеличение плотности электронных состояний на уровне Ферми в наноструктурах  $(\text{Mg}/\text{ZrO}_2)_{52}$  с гранулированными слоями магния после отжига при температуре 873 К.

В основу диссертации положены результаты исследований по следующим научно-исследовательским программам и проектам:

- проект «Нелинейные явления в функциональных и конструкционных гетероструктурах на основе оксидных систем» в рамках базовой части государственного задания (проект №FZGM-2020-0007, 2020-2022 гг.). - проект «Твердофазные гетерогенные среды конструкционного и функционального назначения» в рамках базовой части государственного задания (проект №FZGM-2023-0006, 2023-2025 гг.) - проект «Разработка водородопоглощающей ленты на основе многослойных наноструктур» (программа «УМНИК», договор № 16312ГУ/2021).

**Материалы работы прошли достаточную апробацию.** Материалы, представленные в диссертации были доложены на всероссийских и международных. По материалам диссертации опубликовано 11 печатных работ, в том числе 7 - в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, из которых 5 статей опубликованы в рецензируемых журналах, индексируемых в базе данных Scopus, получен 1 - патент.

Автореферат написан хорошим научным языком, хорошо иллюстрирован и по содержанию полностью соответствует паспорту специальности 1.3.8. Физика конденсированного состояния (пунктам 1, 3, 4 и 6).

## **В качестве замечания можно отметить:**

в автореферате

-не дана информация о скорости отогрева образца при исследовании температурного поведения электросопротивления материалов, хотя, как известно, скорость нагрева играет для этого случая важную роль.

- не указан метод измерения R(T), используемые при этом контактные материалы.

Сделанное замечание не умоляет научную и практическую значимость диссертационной работы.

Судя по содержанию автореферата, диссидент проделал большую и скрупулезную исследовательскую работу, получил доброкачественный экспериментальный материал и дал адекватную теоретическую интерпретацию.

Общая оценка диссертационной работы положительная.

## **Заключение.**

Диссертационная работа Смирнова Андрея Николаевича «Структура, термостойкость и электрические свойства многослойных наноструктур  $(\text{Mg}/\text{NbO}_n)_{82}$ ,  $(\text{Mg}/\text{ZrO}_2)_{52}$ ,  $(\text{Ni}/\text{ZrO}_2)_{72}$ », представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по

специальности 1.3.8. Физика конденсированного состояния, является самостоятельным и законченным научным исследованием, по своей актуальности, новизне и совокупности полученных результатов соответствует критериям, установленным пп. 9-14 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.8. Физика конденсированного состояния.

Доктор физико-математический наук, доцент,  
профессор кафедры нанотехнологий, микроэлектроники, общей и прикладной физики(кафедра  
НМОиПФ):

Игнатенко Николай Михайлович

Даю согласие на обработку моих персональных данных.

Адрес: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 94,  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  
образования «Юго-Западный государственный университет» (ЮЗГУ),  
кафедра «Нанотехнологий, микроэлектроники, общей и прикладной физики»

Диссертация на соискание ученой степени д. ф-м. н. защищена по специальности  
01.04.07 (Физика конденсированного состояния),

Электронная почта [inmkstu@bk.ru](mailto:inmkstu@bk.ru)

Телефон: (4712) 22-26-21

